RF POWER MOSFET
N-Channel Enhancement Mode

DESCRIPTION:

The **ASI BLF245** is a vertical D-MOS transistor designed for large signal amplifier applications in the VHF frequency range.

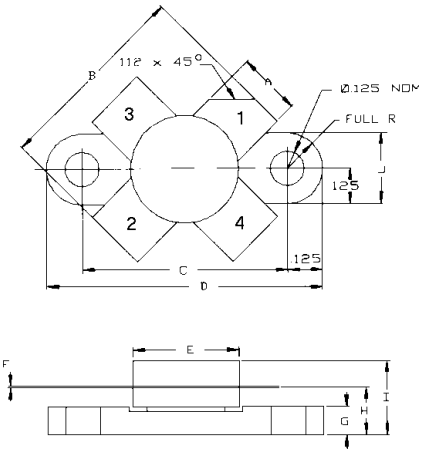
FEATURES INCLUDE:

- P_G = 13 dB Typical at 175 MHz
- **30:1** Load VSWR Capability
- ***Omnigold***™ metalization system

MAXIMUM RATINGS

I_D	6.0 A
V_{DS}	65 V
V_{GS}	±20 V
P_{DISS}	68 W @ T_C = 25 °C
T_J	-65 °C to +150 °C
T_{STG}	-65 °C to +200 °C
θ_{JC}	1.8 °C/W

PACKAGE STYLE .380 4L FLG



	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.220/5,59	.230/5,84
B	.785/19,94	
C	.720/18,29	.730/18,54
D	.970/24,64	.980/24,89
E		.385/9,78
F	.004/0,10	.006/0,15
G	.085/2,16	.105/2,67
H	.160/4,06	.180/4,57
I		.280/7,11
J	.240/6,10	.255/6,48

1 = DRAIN 2 = GATE 3&4 = SOURCE

CHARACTERISTICS T_C = 25 °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS			MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{DSS}	I_D = 10 mA			65			V
I_{DSS}	V_{DS} = 28 V	V_{GS} = 0 V				2.0	mA
I_{GSS}	V_{DS} = 0 V	V_{GS} = ±20 V				1.0	µA
$V_{GS(th)}$	V_{DS} = 10 V	I_D = 10 mA		2.0		4.5	V
g_{fs}	V_{DS} = 10 V	I_D = 1.5 A		1.2	1.9		S
C_{iss} C_{oss} C_{rss}	V_{DS} = 28 V	V_{GS} = 0 V	f = 1.0 MHz		125 75 7.0		pF
P_G η_D	V_{DS} = 28 V	I_{DQ} = 25 mA	P_{out} = 30 W f = 150 MHz	13 50	16 60		dB %
ψ	V_{SWR} = 30:1 AT ALL PHASE ANGLES			NO DEGRADATION IN OUTPUT POWER			

Specifications are subject to change without notice.

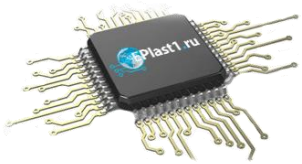
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.